



☆日立の技術者にフィールド賞 米電気電子学会(I E E E)がエレクトロニクス分野で大きな業績を残した研究者を表彰する「I E E Eフィールド賞」を、日立製作所半導体設計開発センターの角南英夫氏(センタ長付)が十三日受

賞した。角南氏が受けたのは、同賞のうちエレクトロニクスの微細加工技術を対象にした「クレド・プルネッティ賞」。D R A M(記憶保持動作が必要な随時読み出し書き込みメモリ)を立体構造化し、記憶容量を増やすトレンチ構造(溝型)セルの開発に先駆けたことが受賞の理由。フィールド賞は、日本人では江崎玲於奈氏や東北大学の西沢潤一学長が受賞している。

日立の角南研究員がノールド賞受賞 日立製作所は十三日、米国際電気学会(I E E E)がエレクトロニクス関連分野で功績のあった研究者に与える「I E E Eフィールド賞」の一部門である「クレド・プルネッティ賞」に日立の半導体設計開発セン

フィールド賞に日立の角南氏

米国際電気電子学会(I E E E)がエレクトロニクス分野で業績のあった研究者を表彰するI E E Eフィールド賞を日立製作所半導体開発センターの角南英夫氏に与え、表彰式は十三日からサンフランシスコで開かれる国際固体回路学会で行われる。



角南氏は受賞したのは同賞のうち、電子装置の小型化を促進するトレンチ構造(溝型)セルの発明と技術開発。I E E Eフィールド賞は日本人では過去に江崎玲於奈氏や東北大学の西沢潤一学長らが受賞している。

賞理由はD R A M(記憶保持動作が必要な随時書き込み・読み出し記憶素子)を立体構造化し、記憶容量を増やすトレンチ構造(溝型)セルの発明と技術開発。

ターの角南(すなみ)英夫研究員が選ばれた、と発表された。角南研究員は同日から米サンフランシスコで開催される国際固体回路学会(I S S C C)で受賞する。

フィールド賞

エレクトロニクス関連分野で顕著な業績を収めた研究者に贈られる一九九一年I E E E(米国際電気電子学会)フィールド賞の一つで、設計開発センターの角南英夫氏がこのほど選ばれた。プルネッティ賞に初回に選ばれた。

日立の角南英夫氏が受賞

トレンチ構造セルなど技術開発に評価

フィールド賞の受賞は日本人としては二人目で、同社としては初めて評価されたもの。これら技術はすでに同社の代表的な半導体関連特許として成立しており、業界でも広く利用されている。

D R A Mのトレンチ(溝型)構造セルとその技術開発に対して評価されたもの。これら技術はすでに同社の代表的な半導体関連特許として成立しており、業界でも広く利用されている。なお、今回のプルネッティ賞の表彰式が十三日(現地時間)から米サンフランシスコで開催される国際固体回路学会(I S S C C)の初回に行われた。

エレクトロニクス

I E E Eフィールド賞受賞

日立製作所・半導体設計開発センターの角南氏 日立製作所は十三日、米国際電気技術者協会(I E E E)から優れた電子技術者に贈られる「I E E Eフィールド賞」の一つ、「クレド・プルネッティ賞」を受賞した。主力半導体製品であるダイナミックR A M(D R A M、記憶保持動作が必要な随時書き込み読み出しメモリ)の構造を説明したことが認められた。クレド賞の受賞は東北大学の岩崎俊一教授に次いで日本人で二人目。クレド賞は電子装置の小型化に大きな業績をあげた技術者に与えられる。角南氏はD R A Mの基本構造の一つであるトレンチ(溝型)と呼ばれる構造を説明し、その技術開発を担当した。角南氏は昭和四十四年に東北大学工学部研究科を修了後、同社に入社、中央研究所で長く半導体の研究に従事した。

日立の角南氏がクレド賞受賞

日立製作所、半導体設計開発センターの角南英夫氏(47)が、米電子電気技術者協会(I E E E)から優れた電子技術者に贈られる「I E E Eフィールド賞」の一つ、「クレド・プルネッティ賞」を受賞した。主力半導体製品であるダイナミックR A M(D R A M、記憶保持動作が必要な随時書き込み読み出しメモリ)の構造を説明したことが認められた。クレド賞の受賞は東北大学の岩崎俊一教授に次いで日本人で二人目。

I E E Eフィールド賞受賞

日立製作所・半導体設計開発センターの角南氏 日立製作所は十三日、米国際電気技術者協会(I E E E)から優れた電子技術者に贈られる「I E E Eフィールド賞」の一つ、「クレド・プルネッティ賞」を受賞した。主力半導体製品であるダイナミックR A M(D R A M、記憶保持動作が必要な随時書き込み読み出しメモリ)の構造を説明したことが認められた。クレド賞の受賞は東北大学の岩崎俊一教授に次いで日本人で二人目。

日立研究員にフィールド賞

日立製作所は十三日、米国際電気電子学会(I E E E)がエレクトロニクス関連分野で功績のあった研究者に与える「I E E Eフィールド賞」の一部門である「クレド・プルネッティ賞」に日立の半導体設計開発センターの角南(すなみ)英夫研究員が選ばれた、と発表した。角南研究員は同日から米サンフランシスコで開かれる国際固体回路学会(I S S C C)で受賞する。



受賞した角南英夫さん

は、半導体の中でも日本の技術力が高いD R A M(記憶保持動作が必要な随時書き込み読み出しメモリ)の微細加工の重要技術であるトレンチ構造といわれる立体加工技術を開発、開発した功績。日本人の受賞は一昨年の岩崎俊一東北大学長に次いで二人目。



日立製作所は十三日、米国際野で功績のあった研究者に与え、IEEEフィールド賞(電気電子学会)の一部門であるクレドール回路学会(ISSCC)で受賞した。受賞の対象となったのは、半導体の中でも日本の技術力が高いDRAM(記憶保持動

# ワールド賞の部門賞 日立・角南研究員に

子会  
電気電子  
米学

作が必要な随時書き込み読み出しメモリー)の微細加工の重要技術であるトレンチ構造といわれる立体加工技術を開発、開発した功績。クレドールフィールド賞は半導体の微細加工部門の賞で、日本人の受賞は、昨年の岩崎俊一東北工科大学長に次いで二人目。ワールド賞の他部門ではこれまで東北大学の西澤潤一学長、IBMの江崎玲於奈氏らが受賞している。



日立製作所(社長・三田勝茂氏)の半導体設計開発センター・角南英夫(すなみ・ひでお)センタ長付「写真」がこのほど、IEEEワールド賞のひとつである「クルドーブルネッティー賞」を受賞した。同賞はデバイスの微細化に貢献した研究者に贈られ、日

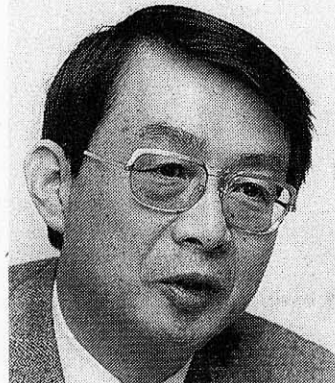
# 「クルドーブルネッティー賞」 日立の角南氏が受賞 トレンチ型セル発明で功績

本では八九年に東北大学電気通信研究所の岩崎俊一教授が受賞したのに続き一人目。角南さんはDRAM(記憶保持動作が必要な随時書き込み読み出しメモリー)のメモリーセル構造で、溝を掘ってキャパシター面積をかせぐトレンチ型セルの発明と、技術開発に業績があったとして、今回の受賞となった。授賞式はサンフランシスコで開催されているISSCCで行われ、受賞者には賞状と賞金一千円が授与される。



コンピューターなどに於奈氏や西沢潤一氏など、枚も書きました。使われる記憶装置「D」大御所の名前が並ぶ。RAM(ダイナミックランダム・アクセス・メモリー)。急速な大容量化の進展は「三年単位」で進んだ。参加した太陽電池の学んだ東北大学で西沢潤一をたたき込まれた。みちのく学派の一人なのだ。

角南 英夫さん  
すなみ ひでお



昭和18年、高松市生まれ。土入せさ47歳。昭和44年に東北大学修士課程終了、日立製作所に入社。現在は半導体設計開発センター長付。夫人の美智子と一男一女の4人暮らし。

の四倍ゲーム」といわれ、基礎となる「トレンチ構造」を発明したのが、この人だ。その業績で、電子工学分野で最も権威のある賞のひとつといわれる「ワールド賞」に輝いた。過去の受賞者には、江崎玲

「西沢先生は獨創性に敵い人でした。それが何とか身につけていたようです。趣味は「収集」。切手、レコードをはじめ「あらゆるものを集めたい」といいます。